２０２５年１２月期第３四半期
決算補足資料（2025年7-9月）

2025年11月11日

証券コード：6871

株式会社 日本マイクロニクス

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

資料取扱い上の注意

本プレゼンテーションで述べられている内容は、当社が現時点で入手している情報及び合理的と判断する前提をもとに構成されたものです。実際の業績や見通し等は、市況、競争状況、半導体・FPD関連業界の世界的な状況等を含む多くの不確実な様々な要因の影響を受けます。従いまして、実際の今後の当社業績や見通しは、本プレゼンテーションにおける記述その他の情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

2025年12月期　第3四半期決算概要

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

決算概要

（単位：百万円、百万円未満切捨）

	2024年12月期	2025年12月期					
	7-9月	4-6月	7-9月	前四半期比		前年同期比	
	Q3 ⓐ	Q2 ⓑ	Q3 ⓒ	増減額 ⓒ-ⓑ	増減率	増減額 ⓒ-ⓐ	増減率
売上高	12,812	18,996	17,291	▲1,704	▲9.0%	+4,479	+35.0%
プローブカード事業	12,376	18,536	16,917	▲1,618	▲8.7%	+4,540	+36.7%
TE事業　※	435	460	374	▲86	▲18.7%	▲61	▲14.1%
売上総利益	6,300	8,787	7,683	▲1,103	▲12.6%	+1,382	+21.9%
営業利益	2,878	4,711	3,730	▲981	▲20.8%	+852	+29.6%
経常利益	3,196	4,492	3,878	▲613	▲13.7%	+681	+21.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,060	3,101	2,309	▲791	▲25.5%	+249	+12.1%

※：Test Equipment

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

決算概要

（単位：百万円、百万円未満切捨）

	2024年12月期	2025年12月期					
	第3四半期累計（1-9月）			8/12開示予想比		前年同期比	
	前年実績 ⓐ	8/12開示予想 ⓑ	実績 ⓒ	増減額 ⓒ-ⓑ	増減率	増減額 ⓒ-ⓐ	増減率
売上高	38,983	50,000	50,412	+412	+0.8%	+11,429	+29.3%
プローブカード事業	37,395	48,700	49,117	+417	+0.9%	+11,722	+31.3%
TE事業 ※	1,588	1,300	1,295	▲4	▲0.4%	▲293	▲18.5%
売上総利益	18,859	―	24,085	―	―	+5,225	+27.7%
営業利益	8,643	11,100	11,300	+200	+1.8%	+2,657	+30.7%
経常利益	9,003	10,800	11,273	+473	+4.4%	+2,269	+25.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,746	6,800	7,084	+284	+4.2%	+1,338	+23.3%

※：Test Equipment

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

2025年12月期第3四半期決算の要点

プローブカード事業

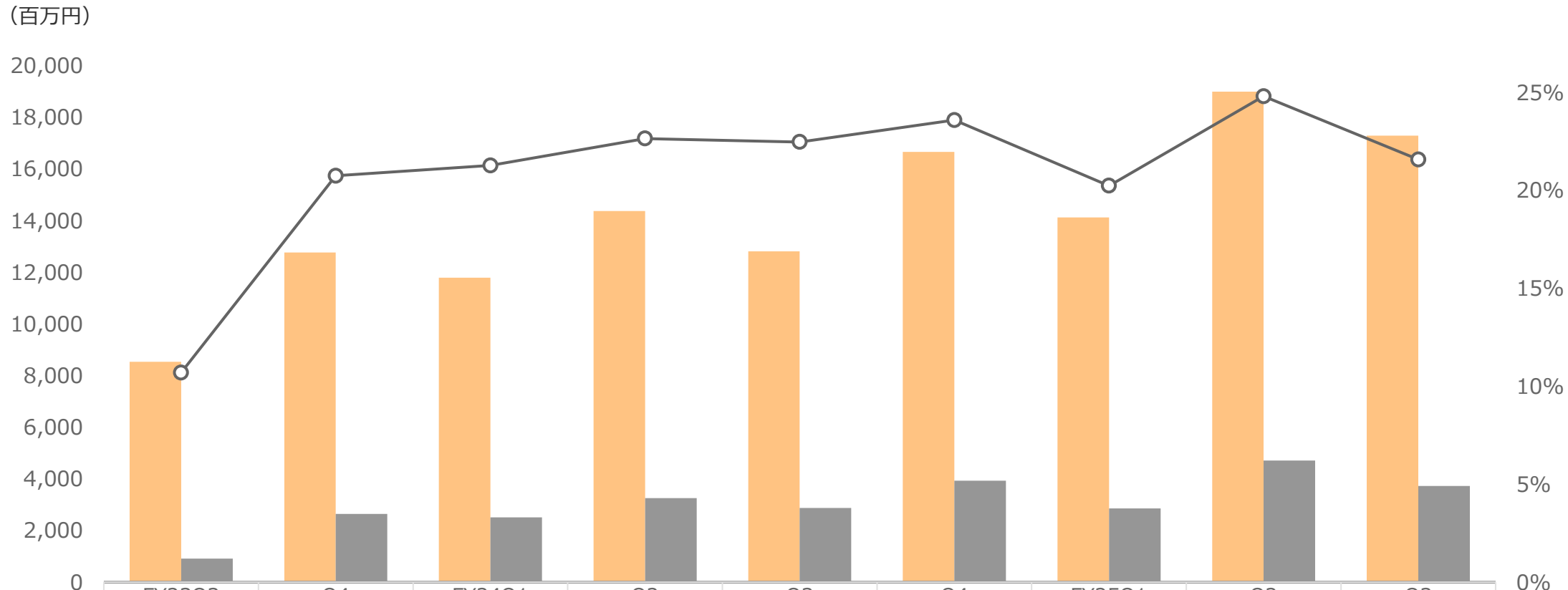
- 受注高は、前四半期比で増加。HBM（高性能メモリ）に対する需要は引き続き好調
- メモリ向けプローブカードの売上高は、第4四半期に予定していた売上高の一部前倒しにより計画に対して若干上振れ
- ノンメモリ向けプローブカードの売上高は、新規顧客への拡販もあり前四半期比で増加
- セグメント利益率は、ミックス変化等の影響により前四半期比で低下

TE事業

- 売上高は、半導体テストソケットが安定的に推移したものの、前四半期比減少
- セグメント利益は、損失を計上

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

四半期業績推移

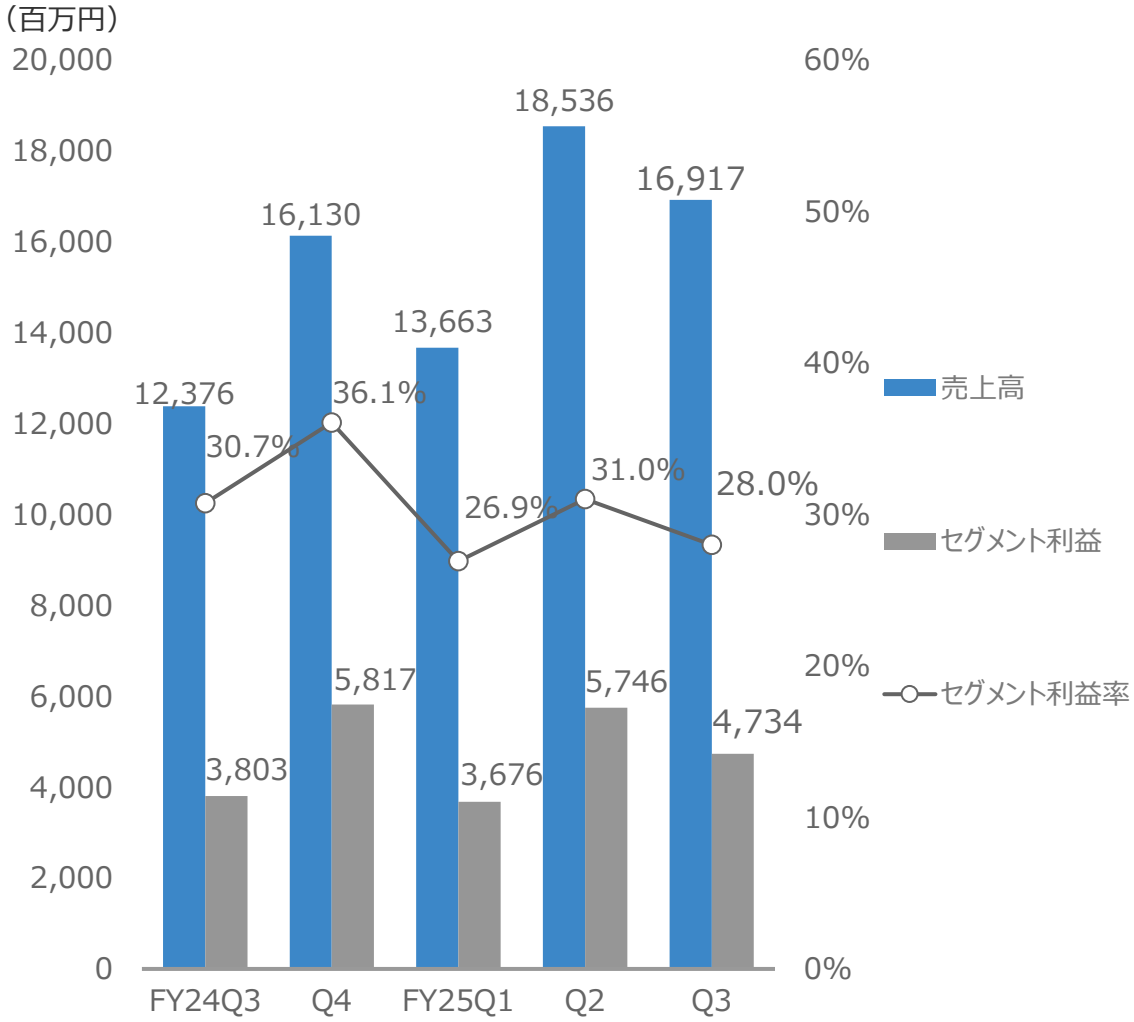


	FY23Q3	Q4	FY24Q1	Q2	Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
売上高	8,537	12,769	11,794	14,376	12,812	16,659	14,124	18,996	17,291
営業利益	913	2,648	2,508	3,255	2,878	3,928	2,857	4,711	3,730
営業利益率	10.7%	20.7%	21.3%	22.6%	22.5%	23.6%	20.2%	24.8%	21.6%

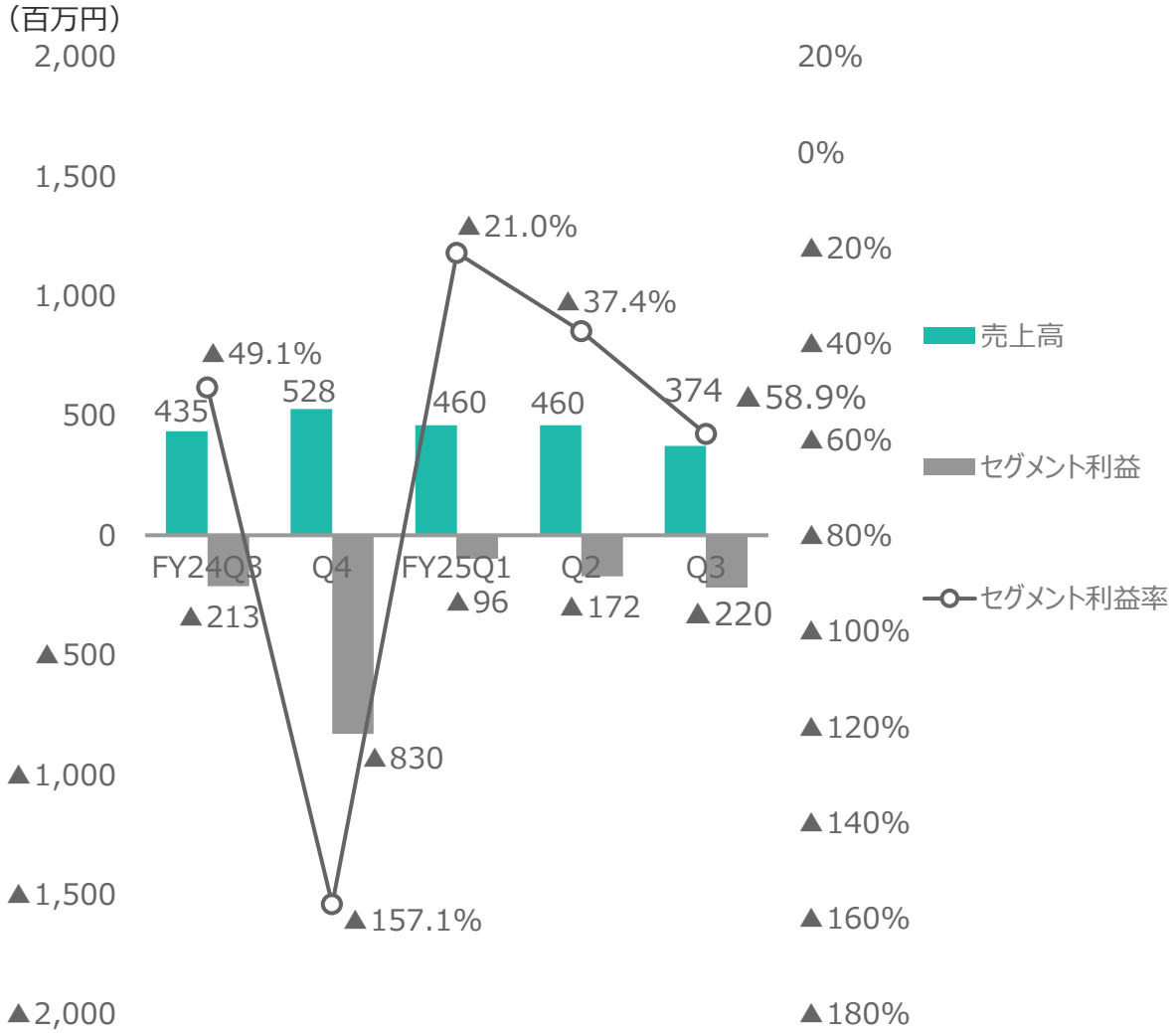
© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

四半期業績推移（セグメント別）

プローブカード事業



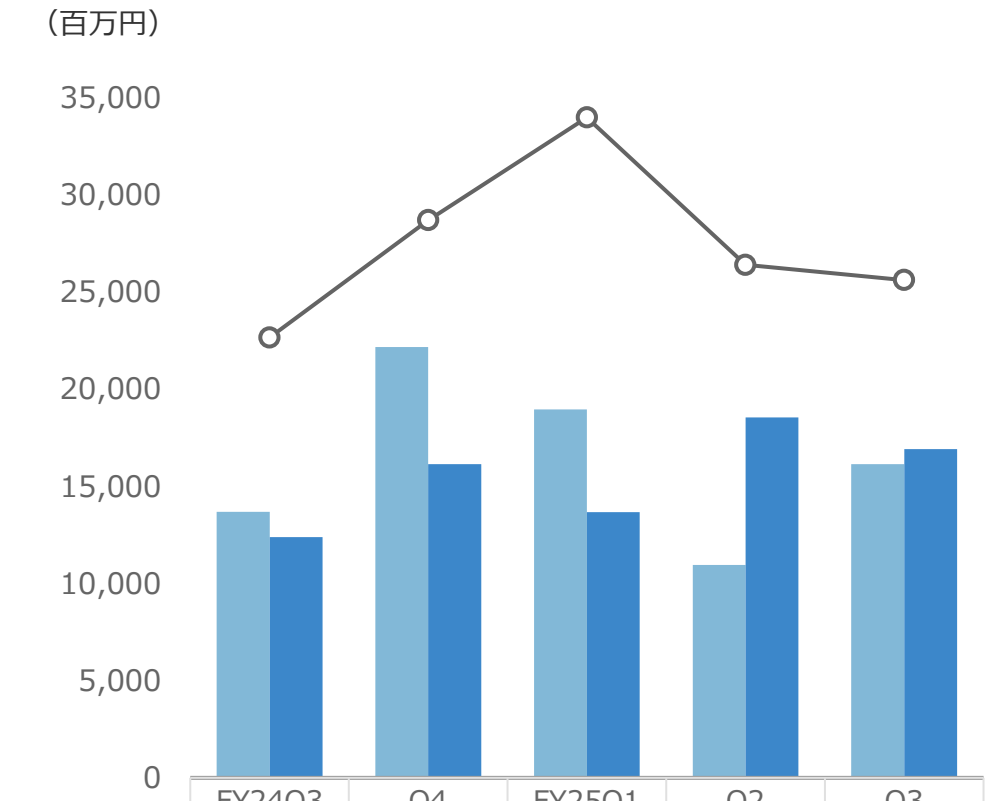
TE事業



© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

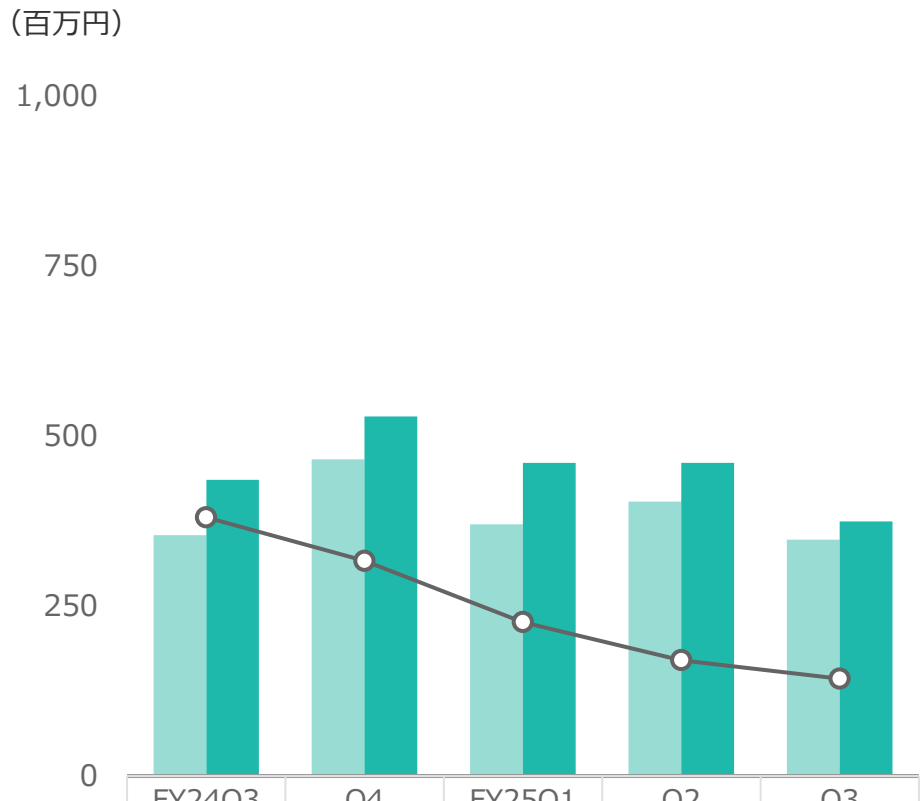
受注/売上/受注残高　四半期推移

プローブカード事業



	FY24Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
受注高	13,684	22,165	18,943	10,955	16,140
売上高	12,376	16,130	13,663	18,536	16,917
受注残高	22,650	28,684	33,965	26,384	25,607

TE事業

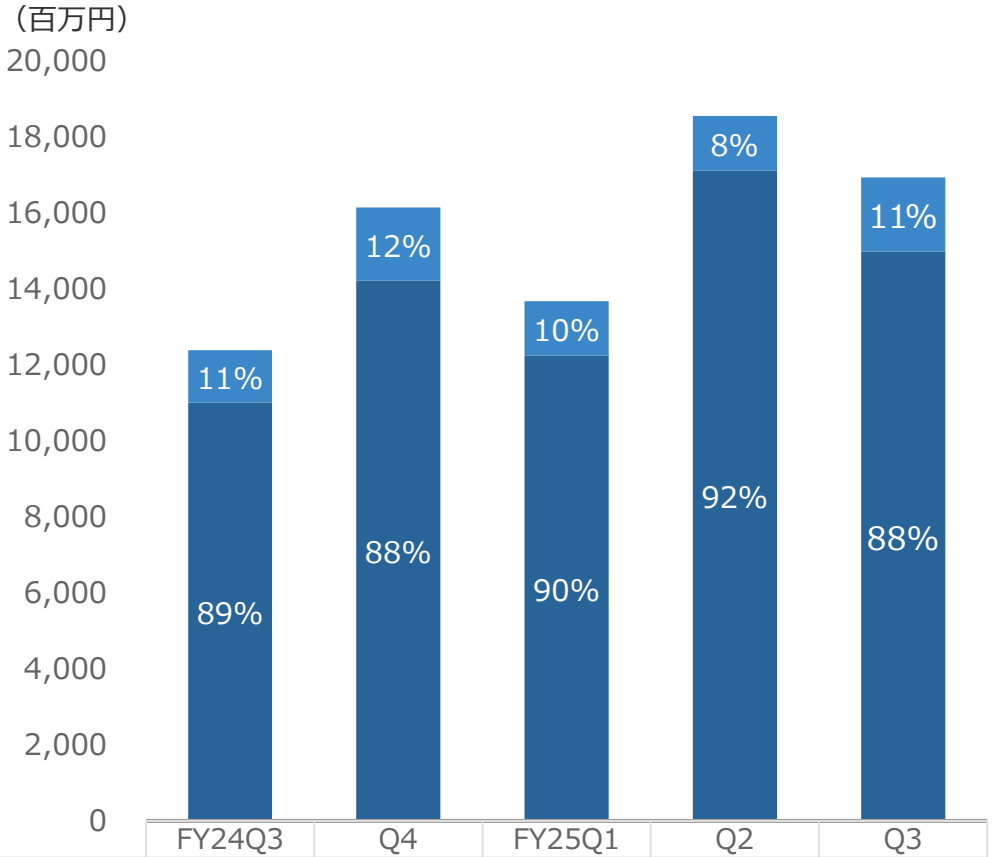


	FY24Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
受注高	354	465	370	403	347
売上高	435	528	460	460	374
受注残高	380	316	226	170	143

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

四半期売上高（製品別）

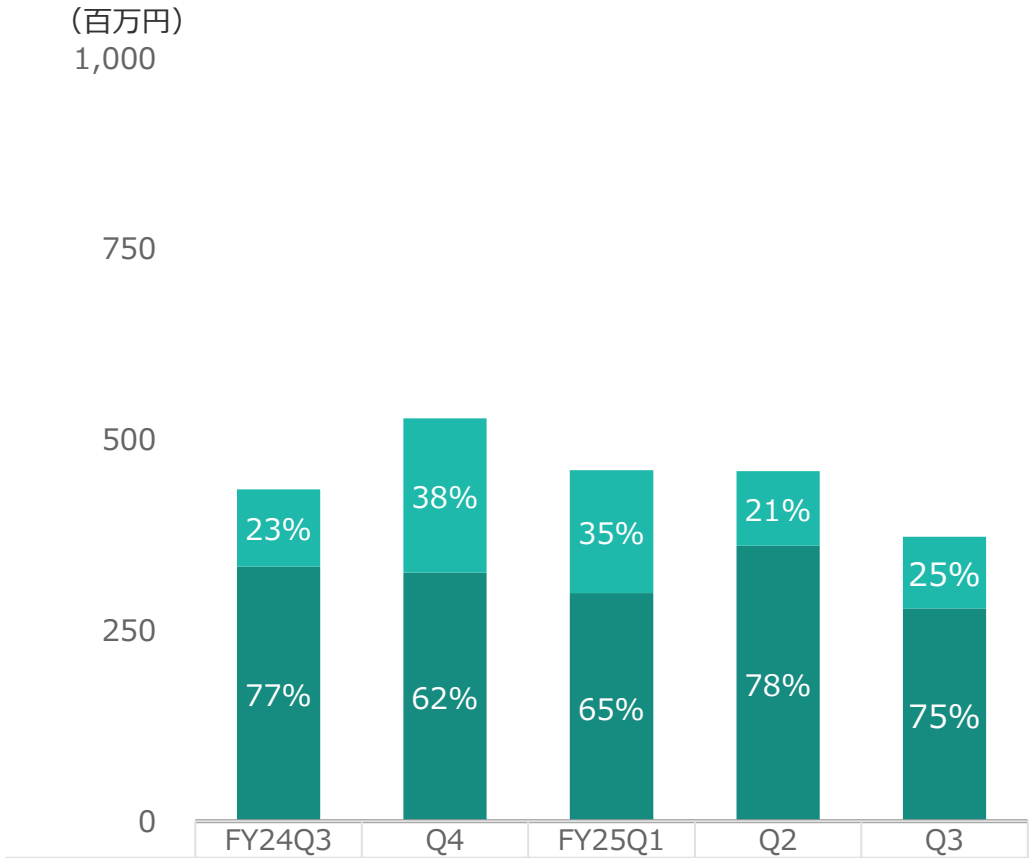
プローブカード事業



	FY24Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
Non-Memory ※	1,381	1,924	1,432	1,437	1,945
Memory	10,996	14,206	12,230	17,098	14,971
計	12,376	16,130	13,663	18,536	16,917

※カンチレバー型の売上高含む

TE事業



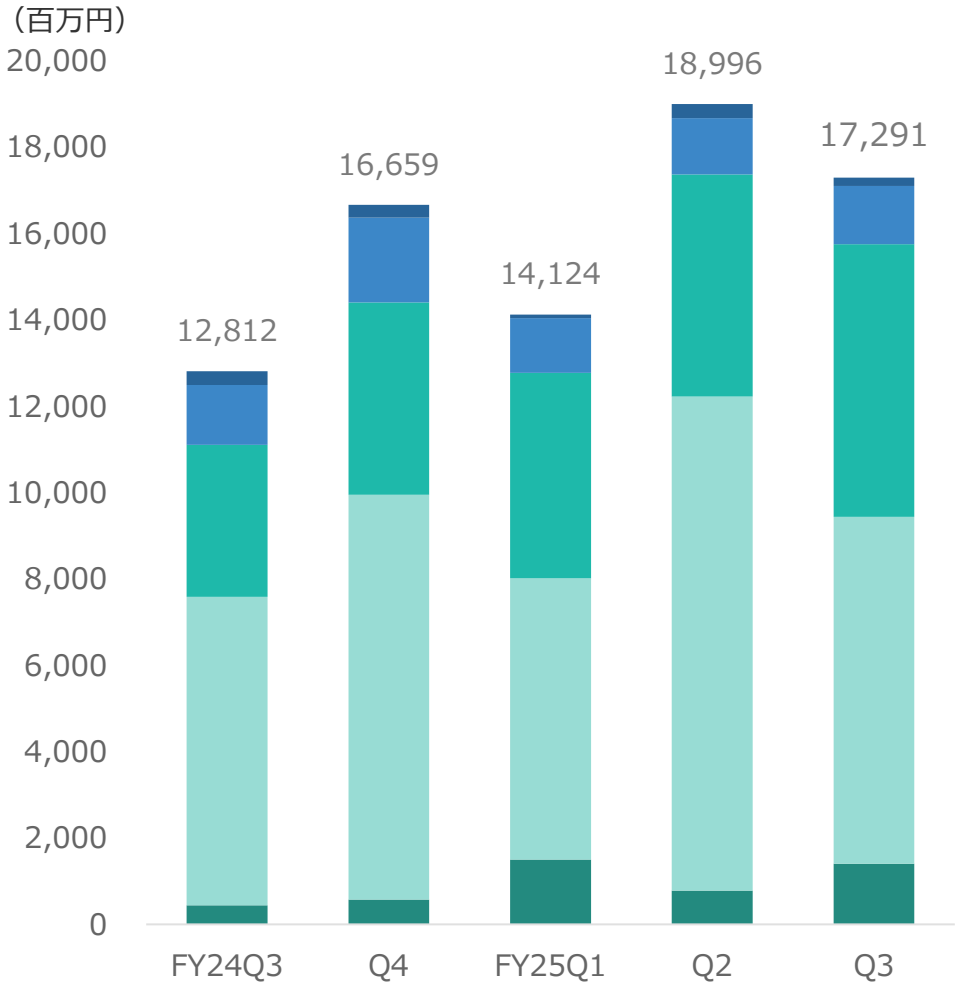
	FY24Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
検査装置 ※1	101	202	161	98	94
検査機器 ※2	334	326	299	361	279
計	435	528	460	460	374

※1 カスタムテスタ、半導体プローバ、FPD向け検査装置など
※2 半導体向けテストソケット、FPD向けプローブユニット

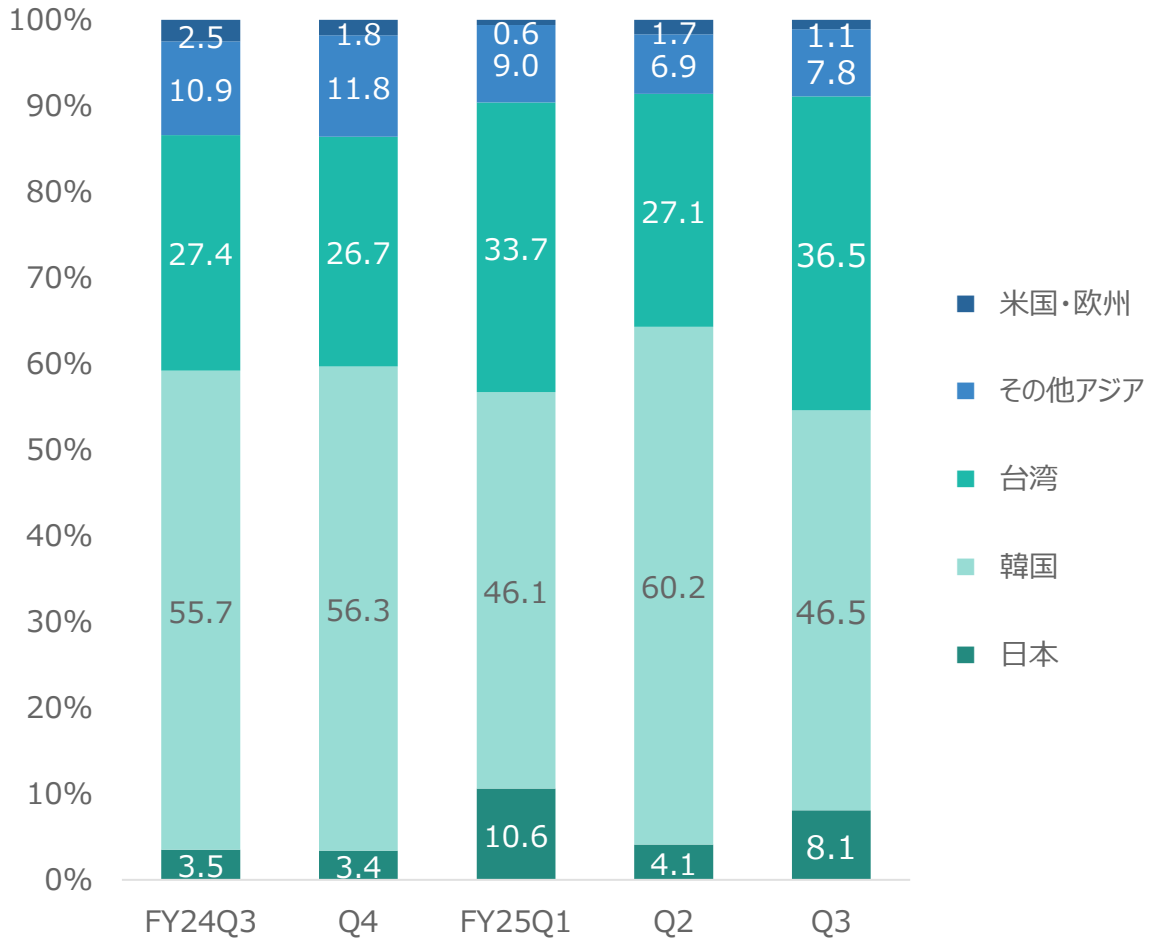
© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

地域別売上高　四半期推移

売上高



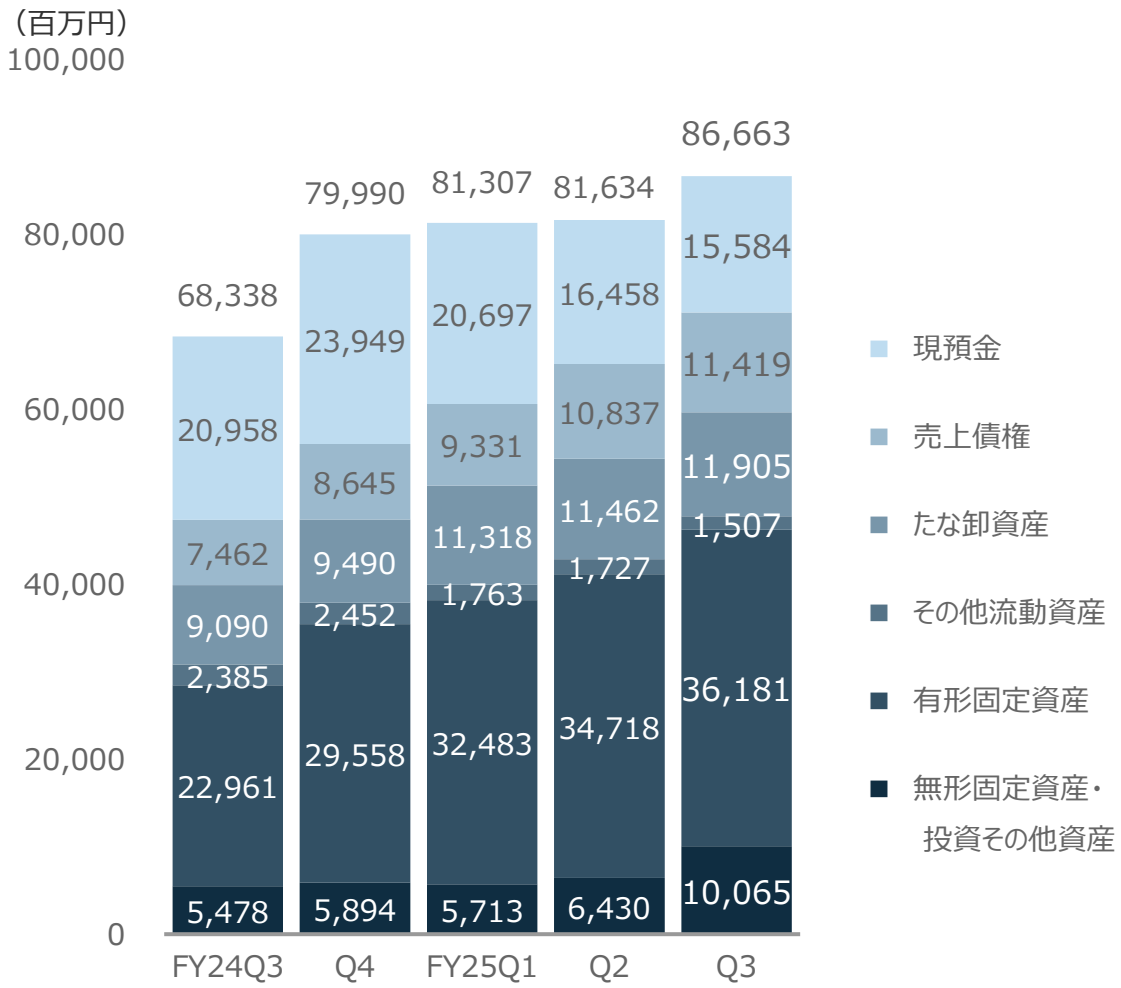
売上高比率



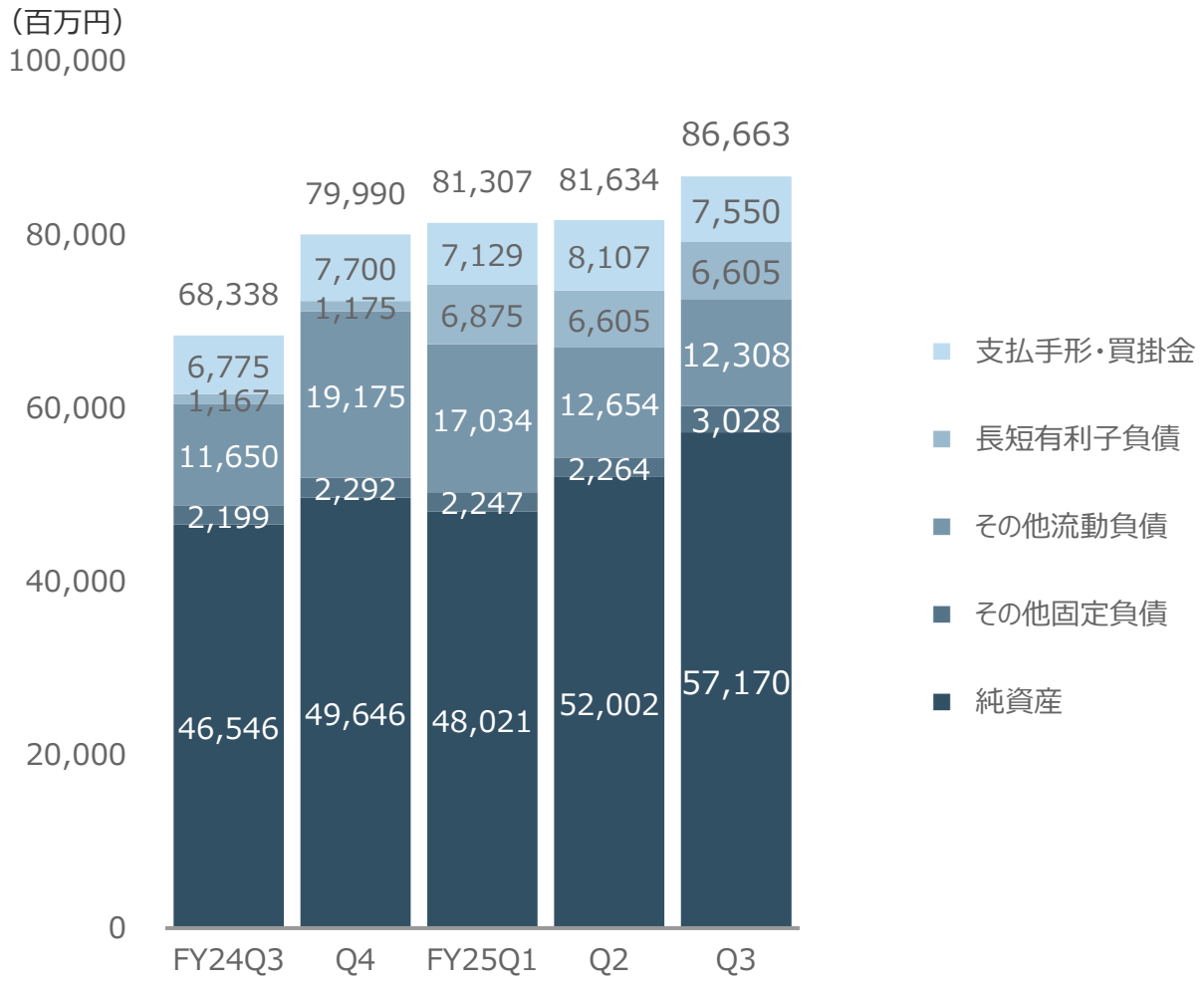
© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

貸借対照表

資産の部



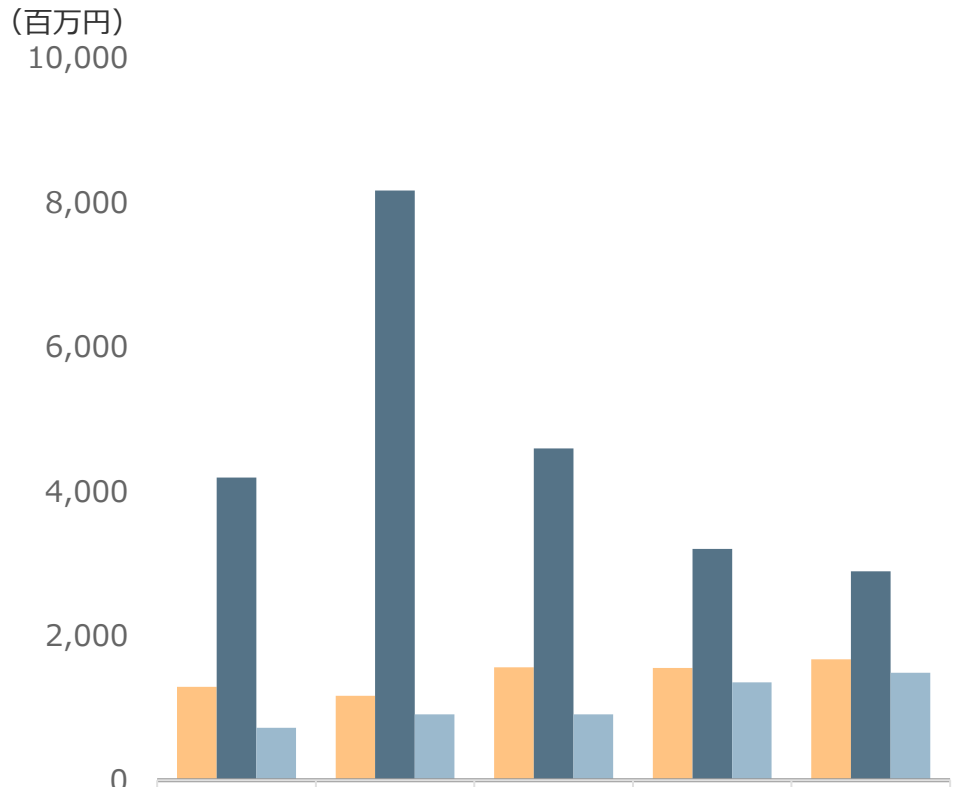
負債純資産の部



© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

投資等/キャッシュフロー

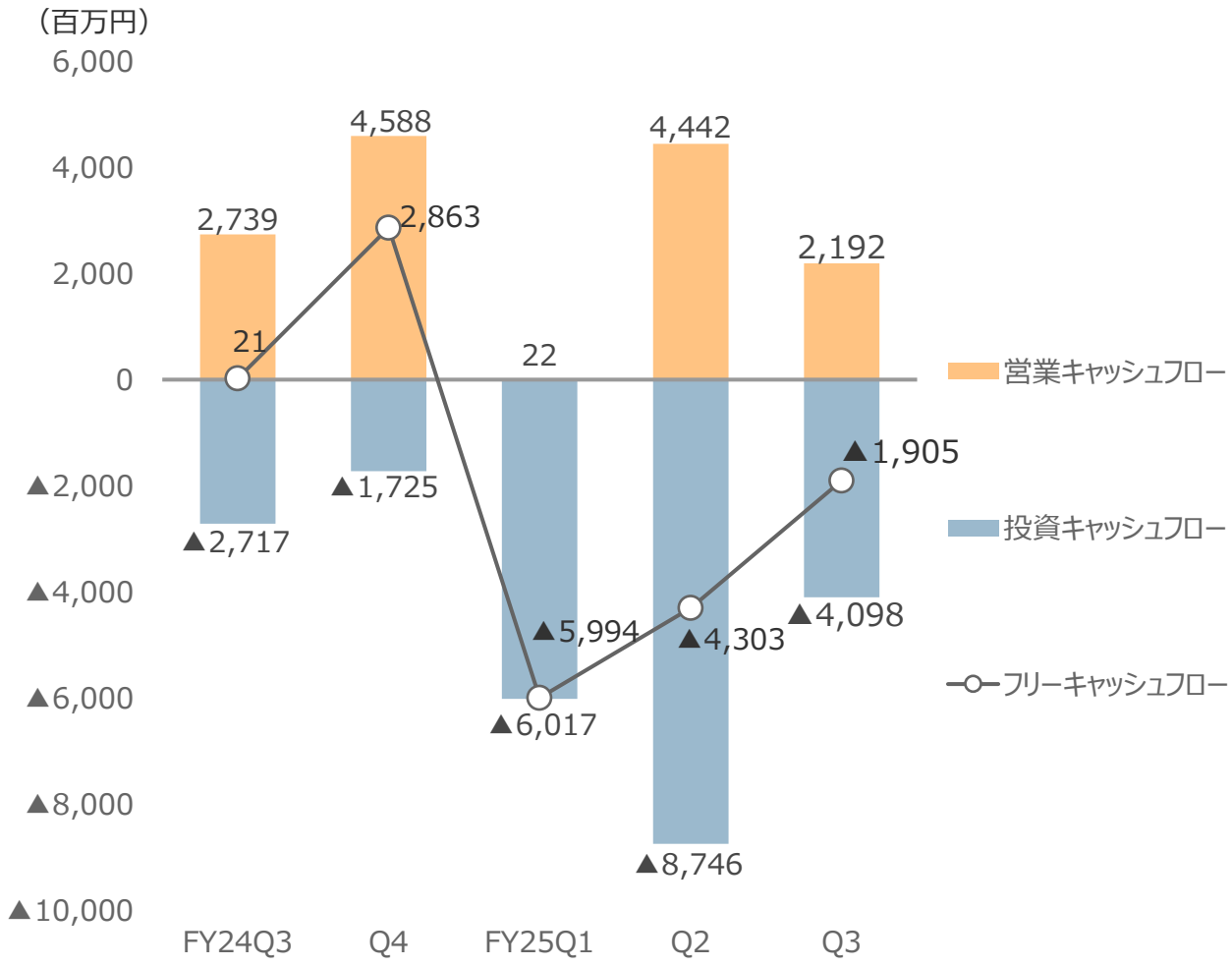
投資等



	FY24Q3	Q4	FY25Q1	Q2	Q3
研究開発費	1,295	1,168	1,564	1,555	1,673
設備投資	4,188	8,161	4,592	3,203	2,893
減価償却費	727	912	914	1,355	1,489

※設備投資には建設仮勘定を含む

キャッシュフロー



© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

業績予想

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

業績予想

- 通期の業績については、8月12日に開示した予想から変更ありません

（単位：百万円、百万円未満切捨）

	通期（累計）業績予想			
	前年1-12月期 ⓐ	1-12（11/11時点） ⓑ	前年同期比	
			増減額 ⓑ-ⓐ	増減率
売上高	55,643	68,900	+13,256	+23.8%
プローブカード事業	53,526	67,100	+13,573	+25.4%
TE事業	2,116	1,800	▲316	▲15.0%
営業利益	12,572	13,800	+1,227	+9.8%
経常利益	12,250	13,300	+1,049	+8.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	8,811	9,200	+388	+4.4%
配当予想（円）	70円	72円	+2円	+2.9%

- 2025年12月期想定レート：USD：147.00円／ドル 、KRW：0.10円／ウォン

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

用語集及び主な製品のご紹介

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

用語集

ウェーハ Wafer **:**
シリコン（Si）やガリウム砒素（GaAs）などを円柱状に結晶化させ、それを薄く切り出した円形状の基板で、表面に半導体の電子回路が形成される。

チップ/ダイ chip/die :
半導体の細片。半導体ウェーハをダイシングして一つの半導体デバイスに切り出したもの。

IC Integrated circuit : 集積回路の総称

メモリIC Memory IC :
情報を電気的に格納して蓄積しておく記憶素子。DRAM、NAND型フラッシュメモリなどの種類がある。

ロジックIC Logic IC :
情報を制御するための論理回路で構成されており、論理演算処理に用いられる。

DRAM Dynamic Random Access Memory :
揮発性メモリの一つ。コンピュータの主記憶装置の他、一般的な汎用メモリとして、広範囲に利用されている。

NAND型フラッシュメモリ Nand-type flash memory :
外部から電源を供給しなくても内容が消えない不揮発性メモリの一つ。USBメモリやデジタルカメラ用メモリカード、携帯音楽プレーヤ、携帯電話の記憶装置として利用されている。東芝が1987年に提案した。

LSI Large Scale Integrated circuit :
大規模集積回路の総称。トランジスタの集積度向上に従って、VLSI、ULSIと呼ばれる。

マイコン Micro computer **:**
演算処理をおこなうマイクロプロセッサとメモリを1チップに集積したICのこと。最近では、家電製品などの電子制御用として組み込まれているものを指すことが多い。

SoC System on chip / **システムLSI** :
システムのほとんどの機能を1 チップ上で実現した大規模なIC。これまで複数のICを組み合わせて構成していた機能を1チップに集約したもの。小型で高性能な機器を実現できる。主に、プロセッサとメモリ、入出力回路、インタフェース回路、通信回路などから構成される。

フリップチップ flip chip :
ICチップを高密度で配線板に表面実装するため、ICチップ表面部の電極にバンプと呼ばれる突起電極があるチップ。この突起と配線板の端子とを半田付け又は導電接着剤で接続する。

バンプ bump :
IC の電極部にメッキ等で形成した突起のこと。通常、金(Au)または半田で形成し、フリップチップ等における基板接続のために使用する。

ボンディングパッド bonding pad:
チップへの電源電圧の供給や外部との信号のやりとりは、通常リード線を介しておこなわれる。このリード線と内部回路の各端子とを接続するため、チップ周辺部に設けた金属電極のことを指す。

IoT Internet of Things :
世の中の様々な機器をインターネットで相互接続し、自動認識や自動制御、遠隔操作等を行うこと。一般的に、通信やセンサなどの半導体が使われる。

FPD Flat Panel Display : フラットパネルディスプレイ

LCD Liquid Crystal Display : 液晶ディスプレイ

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

用語集

ウェーハテスト/プローブテスト Wafer Test/Probe Test：
ウェーハチップのボンディングパット上にプローブ針を当てておこなう電気的試験。

ファイナルテスト/パッケージテスト Wafer Test/Probe Test：
組立て完了したICに対しておこなう電気的試験。

DUT device under test：試験対象となるデバイス。

エリアアレイ Area array：検査パッドがチップ表面に格子状に配列された状態のこと。

カンチレバー型プローブカード：
片持ち針型とも言う。ニードルプローブの片側を支点としてプロービングするプローブカードのこと。手作業により形成。

アドバンストプローブカード：
カンチレバー型以外のプローブカードの総称。

垂直型プローブカード Vertical Probe Card：
基板に対しプローブが垂直に立てられているプローブカードのこと。エリアアレイ、小パッド、低電圧、低針圧、高周波の測定に適している。

MEMS micro electro-mechanical systems：
微小電気機械システム。

MEMS型プローブカード MEMS Type Probe Card：
MEMS技術を利用したプローブカード。プローブ端子自体が何らかの機械的動作を持つ構造。

DFT Design for testability：
テスト容易化設計。設計の初期の段階からテストのし易さを考慮して、テスト用回路の組み込み等を行う設計手法。

BIST Built In Self Test：組み込み自己検査。DFTの一つ。

AI Artificial Intelligence：
コンピュータ上などで人工的に人間と同様の知能を実現させようとする技術。一般的に、画像処理などの半導体が使われる。

生成AI：
オリジナルの画像・動画・テキスト・映像など多様な形式のデータを自動的に生成する技術。事前に収集・分析した膨大なデータを学習し、新たなコンテンツを生成できることが特徴。生成AIが性能を発揮するためには、GPUやHBMといった高性能半導体が不可欠。

GPU Graphics Processing Unit：
3Dグラフィックスなどの膨大なデータの計算処理をおこなう半導体チップで、並列計算能力が高い。特に生成AI向けは、HBMを組み合わせて使うことでより高速な処理をおこなう。

HBM High Bandwidth Memory：
広帯域かつ消費電力効率の高いDRAMの一種。DRAMチップを積層し、多数のバスを用いてプロセッサと接続することで、高速で大容量のデータ転送を実現する。主にGPU/CPUとパッケージングされ、HPCやAIサーバなどに搭載される。

HPC High Performance Computing:
膨大なデータに対して複雑な演算処理を高速に実行する技術で、高性能なプロセッサを使用してビッグデータを処理することが可能。

汎用サーバ：
ユーザーからの要求に対し、ネットワークを通じて必要な処理をおこなうコンピュータやプログラム。

AIサーバ：
生成AIの学習と推論に特化した特殊なサーバ。強力なCPU、GPU、HBM、その他のデバイスが搭載され、より高い計算能力、大容量のメモリストレージ、高帯域幅、低遅延などの特性を持つ。

データセンタ：
サーバやネットワーク機器を安全に保管するための施設。データセンタ向け投資が活発になると、汎用サーバが多く使用され、そこに搭載されるDRAMチップの需要が増加する。

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

主な製品のご紹介

プローブカード事業

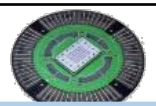
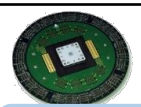
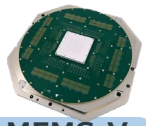
U-Probe：
当社独自のMEMSプローブ"マイクロカンチレバー"と世界トップレベルの薄膜多層技術により、世界で初めてウェーハスケールのプロービングを実現した当社の主力製品。
DRAM向けクレッセント（三日月）配置は、コンタクト回数を極限まで減らしたことで、現在業界のスタンダードとなりました。主に、DRAMやフラッシュメモリ等メモリ検査に使用される。

SP-Probe：
12インチウェーハー括測定に適した垂直型スプリング・ピンタイプのプローブカード。主に、NANDフラッシュメモリ検査に使用される。

MEMS-V / Vertical-Probe：
高集積化・高速化・多ピン化するロジック検査用の垂直型ニードルタイプのプローブカード。あらゆるパッド配列に対し柔軟な対応が可能で、狭ピッチのエリアアレイ配置、多数個同時測定に適し、SoC等先端ロジック検査に適している。

MEMS-SP：
SoCデバイス等のフリップチップタイプのロジック検査用に開発したMEMSプローブ使用のプローブカード。

当社プローブカード製品の主な用途

	Memory		Logic
	DRAM	Flash	SoC
垂直型		SP-Probe	 Vertical-Probe  SP−Probe
MEMS型	U-Probe		 MEMS-V MEMS-SP

TE事業

半導体テスタ：
半導体デバイスに電気信号などを与え、出力される信号を期待値と比較することで、設計仕様通りに動作するかどうかを検査する装置。

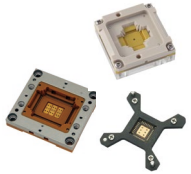
ウェーハプローバ：
ウェーハを搬送しデバイス上の決められた位置にコンタクトするために使用する装置。

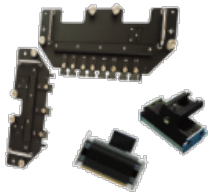
テストソケット：
半導体製造の最終検査で、パッケージされたデバイスとテスタを電気的に繋ぐ役目をもつ治具。
高周波・高性能デバイスに適した"J-Contacts"と、接触安定性に優れた独自構造のスプリングプローブをもつ"BeeContacts"の２タイプ。

プローブユニット：
LCDプローバに搭載するLCD版プローブカード。当社が開発したブレードタイプは業界のスタンダードとなりました。

半導体テスタ

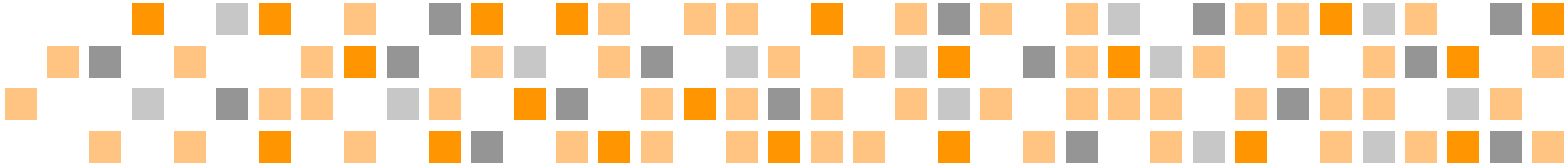
ウェーハプローバ


テストソケット


プローブユニット

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.

MJC YOUR Best Partner, MJC Anytime Anywhere



本資料で述べられている技術情報は、製品の標準的動作・応用を説明するためのものであり、その使用に際して当社および第三者の知的財産、その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行なうものではありません。

株式会社 日本マイクロニクス

© 2025 MICRONICS JAPAN CO., LTD.